

請求の範囲

- [請求項1] 昇華性物質を含む昇華性膜形成組成物であって、
前記昇華性物質の飽和溶解度が10質量%超である溶媒A2と、
当該昇華性膜形成組成物中における含有量が前記溶媒A2の含有量より大きく、沸点が、前記昇華性物質の1気圧における沸点より小さく、かつ、前記溶媒A2の沸点より小さい溶媒B2と、を含む、
昇華性膜形成組成物。
- [請求項2] 請求項1に記載の昇華性膜形成組成物であって、
当該昇華性膜形成組成物中における前記溶媒B2の含有量が、50質量%以上である、昇華性膜形成組成物。
- [請求項3] 請求項1または2に記載の昇華性膜形成組成物であって、
前記溶媒A2の沸点と前記溶媒B2の沸点との差分が、5℃以上である、昇華性膜形成組成物。
- [請求項4] 昇華性物質と、
前記昇華性物質の飽和溶解度が10質量%超であり、沸点が前記昇華性物質の1気圧における沸点より5℃以上低い溶媒A1と、
を含む、昇華性膜形成組成物。
- [請求項5] 請求項4に記載の昇華性膜形成組成物であって、
沸点が前記溶媒A1の沸点より小さい溶媒B1を含む、昇華性膜形成組成物。
- [請求項6] 請求項4または5に記載の昇華性膜形成組成物であって、
当該昇華性膜形成組成物中における前記溶媒A1の含有量が、50質量%以上である、昇華性膜形成組成物。
- [請求項7] 請求項1～6のいずれか一項に記載の昇華性膜形成組成物であって、
、
前記昇華性物質の凝固熱が、200J/g以下である、昇華性膜形成組成物。
- [請求項8] 請求項1～7のいずれか一項に記載の昇華性膜形成組成物であって

- 、
前記昇華性物質の1気圧における凝固点が、5℃以上である、昇華性膜形成組成物。
- [請求項9] 請求項1～8のいずれか一項に記載の昇華性膜形成組成物であって、
、
昇華性物質の1気圧における沸点が、300℃以下である、昇華性膜形成組成物。
- [請求項10] 請求項1～9のいずれか一項に記載の昇華性膜形成組成物であって、
、
前記昇華性物質の含有量が、当該昇華性膜形成組成物中、80質量%以下である、昇華性膜形成組成物。
- [請求項11] 請求項1～10のいずれか一項に記載の昇華性膜形成組成物であって、
基板上に形成された凹凸構造のパターン倒れを抑制するために用いる、昇華性膜形成組成物。
- [請求項12] 請求項11に記載の昇華性膜形成組成物であって、
パターン寸法が30nm以下である凹凸構造を有する基板を処理するために用いる、昇華性膜形成組成物。
- [請求項13] 請求項12に記載の昇華性膜形成組成物であって、
前記パターン寸法が20nm以下である凹凸構造を有する前記基板を処理するために用いる、昇華性膜形成組成物。
- [請求項14] 表面に凹凸構造を有する基板を準備する工程と、
前記表面に、昇華性物質を含む昇華性膜形成組成物を供給する工程と、
前記昇華性膜形成組成物を凝固させ、前記表面に昇華性膜を形成する工程と、
前記昇華性物質を昇華させて前記昇華性膜を除去する工程と、
を含み、

前記昇華性物質を含む昇華性膜形成組成物が、請求項 1 ～ 10 のいずれか一項に記載の昇華性膜形成組成物である、
基板の製造方法。

[請求項15] 請求項 14 に記載の基板の製造方法であって、
前記基板は、パターン寸法が 30 nm 以下である前記凹凸構造を前記表面に有するものである、基板の製造方法。

[請求項16] 請求項 15 に記載の基板の製造方法であって、
前記基板は、前記パターン寸法が 20 nm 以下である前記凹凸構造を前記表面に有するものである、基板の製造方法。